

**NPN/PNP Silicon Digital Transistor Array**

- Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit
- Two (galvanic) internal isolated NPN/PNP Transistors in one package
- Built in bias resistor NPN and PNP ( $R_1=10\text{ k}\Omega$ ,  $R_2 =10\text{ k}\Omega$ )
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101


**Tape loading orientation**


Type	Marking	Pin Configuration					Package	
BCR10PN	W1s	1=E1	2=B1	3=C2	4=E2	5=B2	6=C1	SOT363

**Maximum Ratings for NPN and PNP Types**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	$V_{CEO}$	50	V
Collector-base voltage	$V_{CBO}$	50	V
Input forward voltage	$V_{i(fwd)}$	40	V
Input reverse voltage	$V_{i(rev)}$	10	V
DC collector current	$I_C$	100	mA
Total power dissipation, $T_S = 115\text{ }^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	250	mW
Junction temperature	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	$T_{stg}$	-65 ... 150	$^\circ\text{C}$

**Thermal Resistance**

Junction - soldering point <sup>1)</sup>	$R_{thJS}$	$\leq 140$	K/W
--	------------	------------	-----

<sup>1)</sup>For calculation of  $R_{thJA}$  please refer to Application Note AN077 (Thermal Resistance Calculation)

**Electrical Characteristics** at  $T_A=25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>DC Characteristics</b> for NPN and PNP Types					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}, I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	50	-	-	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\ \mu\text{A}, I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}$	50	-	-	
Collector cutoff current $V_{CB} = 40\ \text{V}, I_E = 0$	$I_{CBO}$	-	-	100	nA
Emitter cutoff current $V_{EB} = 10\ \text{V}, I_C = 0$	$I_{EBO}$	-	-	0.75	mA
DC current gain 1) $I_C = 5\ \text{mA}, V_{CE} = 5\ \text{V}$	$h_{FE}$	30	-	-	-
Collector-emitter saturation voltage1) $I_C = 10\ \text{mA}, I_B = 0.5\ \text{mA}$	$V_{CEsat}$	-	-	0.3	V
Input off voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}, V_{CE} = 5\ \text{V}$	$V_{i(off)}$	0.8	-	1.5	
Input on Voltage $I_C = 2\ \text{mA}, V_{CE} = 0.3\ \text{V}$	$V_{i(on)}$	1	-	2.5	
Input resistor	$R_1$	7	10	13	k $\Omega$
Resistor ratio	$R_1/R_2$	0.9	1	1.1	-
<b>AC Characteristics</b> for NPN and PNP Types					
Transition frequency $I_C = 10\ \text{mA}, V_{CE} = 5\ \text{V}, f = 100\ \text{MHz}$	$f_T$	-	130	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{CB} = 10\ \text{V}, f = 1\ \text{MHz}$	$C_{cb}$	-	3	-	pF

 1) Pulse test:  $t < 300\ \mu\text{s}; D < 2\%$

**NPN Type**

**DC Current Gain  $h_{FE} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 5V$  (common emitter configuration)



**Collector-Emitter Saturation Voltage**

$V_{CEsat} = f(I_C), h_{FE} = 20$



**Input on Voltage  $V_{i(on)} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 0.3V$  (common emitter configuration)



**Input off voltage  $V_{i(off)} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 5V$  (common emitter configuration)



**PNP Type**

**DC Current Gain  $h_{FE} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 5V$  (common emitter configuration)



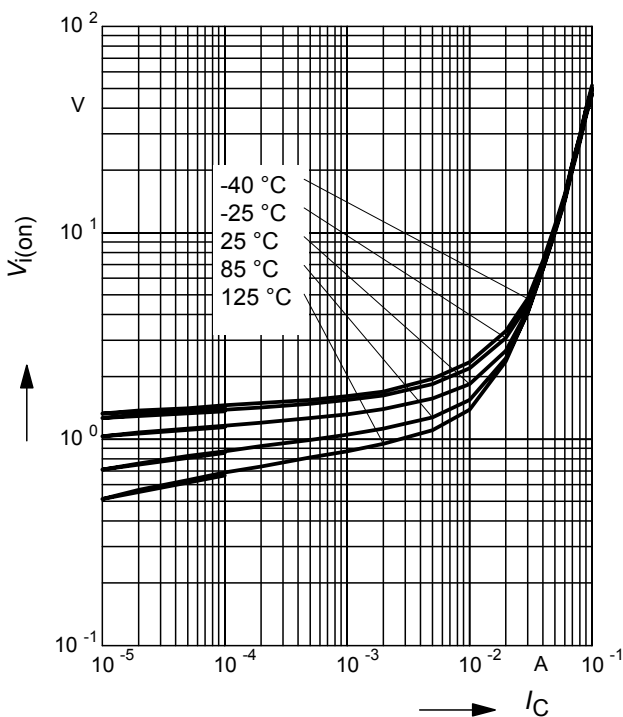
**Collector-Emitter Saturation Voltage**

$V_{CEsat} = f(I_C), h_{FE} = 20$



**Input on Voltage  $V_{i(on)} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 0.3V$  (common emitter configuration)

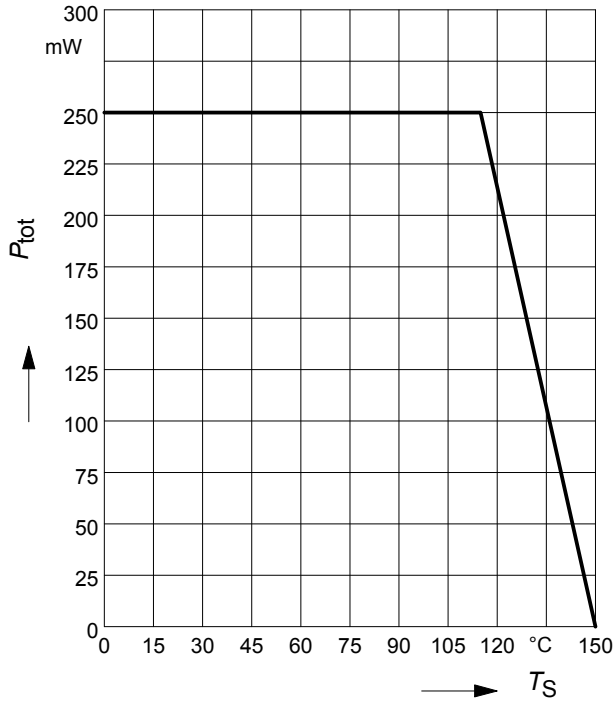


**Input off voltage  $V_{i(off)} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 5V$  (common emitter configuration)



**Total power dissipation  $P_{tot} = f(T_S)$**



**Permissible Pulse Load  $R_{thJS} = f(t_p)$**



**Permissible Pulse Load**

$P_{totmax} / P_{totDC} = f(t_p)$



### Package Outline



### Foot Print



### Marking Layout (Example)

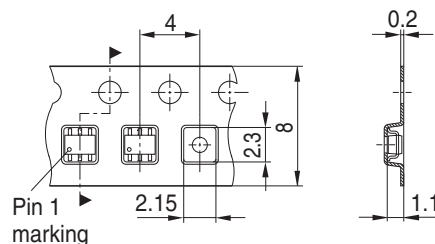
Small variations in positioning of Date code, Type code and Manufacture are possible.



### Standard Packing

Reel  $\varnothing$ 180 mm = 3.000 Pieces/Reel  
 Reel  $\varnothing$ 330 mm = 10.000 Pieces/Reel

For symmetric types no defined Pin 1 orientation in reel.



**Edition 2009-11-16**

**Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

### **Legal Disclaimer**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

### **Information**

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

### **Warnings**

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.